



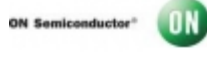





	<h2>H11A817B3SD</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: H11A817B3SD</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4SMD</p> <p>Datenblätter:  H11A817B3SD.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 20000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	H11A817B3SD
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4SMD
Kategorie	Isolatoren > Optoisolatoren - Transistor, Photovoltaik-
Teilstatus	20000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Optoisolator Transistor Output 5300Vrms 1 Channel 4-
Serie	-
Eingabetyp	DC
Betriebstemperatur	-55°C ~ 100°C
Befestigungsart	Surface Mount
Ausgabetyp	Transistor
Anzahl der Kanäle	1
Verpackung / Gehäuse	4-SMD, Gull Wing
Supplier Device-Gehäuse	4-SMD
Strom - Ausgang / Kanal	50mA
Spannung - Isolation	5300Vrms
Aufstieg / Fallzeit (Typ)	2.4µs, 2.4µs
Spannung - Ausgabe (max)	70V
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ)	1.2V
Strom - DC Vorwärts (If) (Max)	50mA
Gleichstrom-Übertragungsverhältnis (min)	130% @ 5mA
Stromübertragungsverhältnis (max)	260% @ 5mA
Ein- / Ausschaltzeit (Typ)	-
VCE Sättigung (max)	200mV
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

H11A817B3SD ist neu im Original, Suche H11A817B3SD Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie H11A817B3SD AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage H11A817B3SD: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>H11A817B300W AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP</p>	 <p>H11A817BSD Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4SMD</p>	 <p>H11A817B3S AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4SMD</p>	 <p>H11A817BSD AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4SMD</p>
 <p>H11A817B3SD Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4SMD</p>	 <p>H11A817B3S Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4SMD</p>	 <p>H11A817B300W Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4DIP</p>	 <p>H11A817BS Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANSISTOR 4SMD</p>

heiße Teile

Mehr

 H11A617B300	 H11A617B300	 H11A617B3SD	 H11A617B3SD	 H11A617BS
 H11A617BS	 H11A617BSD	 H11A617BSD	 H11A617CSD	 H11A617CSD
 H11A617D3SD	 H11A617D3SD	 H11A814C	 H11A817A	 H11A817A
 H11A817A.3SD	 H11A817A3SD	 H11A817A3SD	 H11A817ASD	 H11A817ASD
 H11A817B	 H11A817B	 H11A817B.3SD	 H11A817B300	 H11A817B300
 H11A817B3SD	 H11A817BSD	 H11A817BSD	 H11A817BW	 H11A817BW
 H11A817C	 H11A817C	 H11A817C300	 H11A817C300	 H11A817C3SD
 H11A817C3SD	 H11A817CSD	 H11A817CSD	 H11A817CW	 H11A817CW
 H11A817SD	 H11A817SD	 H11A817X	 H11A817X-5627W	 H11A817X-5632
 H11AA1-X007T	 H11AA1-X007T	 H11AA1SR2M	 H11AA1SR2M	 H11AA1TM

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited